

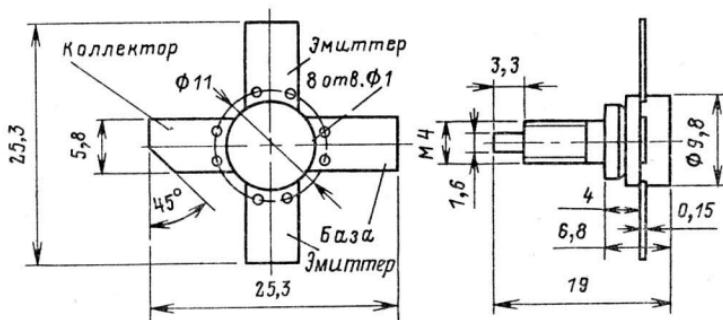
2T920A, 2T920Б, 2T920В, KT920A, KT920Б, KT920Б, KT920Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* генераторные высокочастотные.

Предназначены для применения в схемах усилителей мощности, в том числе с амплитудной модуляцией, умножителях частоты и автогенераторах на частотах 50–200 МГц при напряжении питания 12,6 В.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими ленточными выводами и монтажным винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4,5 г.



Электрические параметры

Выходная мощность при $U_{КЭ} = 12,6$ В, $f = 175$ МГц,
 $T_k \leq 313$ К:

2T920A, KT920A	2 Вт
2T920Б	7 Вт
KT920Б	5 Вт
2T920В, KT920В	20 Вт
KT920Г	15 Вт

Коэффициент усиления по мощности при $U_{КЭ} = 12,6$ В,
 $f = 175$ МГц:

2T920A, KT920A $P_{\text{вых}} = 2$ Вт не менее	7
типовое значение	12*
2T920Б, KT920Б $P_{\text{вых}} = 5$ Вт не менее	4,5
типовое значение	9*
2T920В, KT920В $P_{\text{вых}} = 20$ Вт не менее	3
типовое значение	4*
KT920Г $P_{\text{вых}} = 15$ Вт не менее	3

Коэффициент полезного действия коллектора

2T920A, 2T920Б, 2T920В не менее	60 %
типовое значение	70* %
KT920А, KT920Б, KT920В, KT920Г не менее	55 %

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером* при $U_{K3} = 5$ В:

2T920A при $I_K = 50$ мА, типовое значение	30
2T920Б при $I_K = 100$ мА, типовое значение	40
2T920В при $I_K = 250$ мА, типовое значение	25

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер*:

2T920A при $I_K = 50$ мА, $I_B = 10$ мА, типовое значение	0,3 В
2T920Б при $I_K = 100$ мА, $I_B = 20$ мА, типовое значение	0,4 В
2T920В при $I_K = 250$ мА, $I_B = 50$ мА, типовое значение	0,45 В

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100$ МГц, $U_{K3} = 10$ В:

2T920A, KT920A при $I_K = 0,2$ А не менее	4
типовое значение	7,5*
2T920Б, KT920Б при $I_K = 0,4$ А не менее	4
типовое значение	7*
2T920В, KT920В при $I_K = 1,0$ А не менее	4
типовое значение	4,5*
KT920Г при $I_K = 1,0$ А не менее	3,5

Критический ток коллектора* при $U_{K3} = 10$ В, $f = 100$ МГц:

2T920A, KT920A не менее	0,8 А
типовое значение	1,0 А
2T920Б, KT920Б не менее	1,5 А
типовое значение	2,0 А
2T920В, KT920В не менее	4,5 А
типовое значение	7,0 А
KT920Г не менее	4,0 А

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{K3} = 10$ В, $f = 5$ МГц:

при $I_\beta = 30$ мА 2T920A, 2T920Б, KT920A, KT920Б не более	20 пс
типовое значение	7 пс
при $I_\beta = 150$ мА 2T920Б, KT920Б, KT920Г не более	20 пс
типовое значение	9* пс

Емкость коллекторного перехода при $U_{K3} = 10$ В, $f = 5$ МГц:

2T920A не более	15 пФ
типовое значение	10* пФ
2T920Б не более	25 пФ
типовое значение	16* пФ
2T920В не более	75 пФ
типовое значение	50* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{B3} = 0$, $f = 5$ МГц не более:

2T920A	55 пФ
2T920Б	100 пФ
2T920В	410 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 36$ В, $R_{ЭБ} = 100$ Ом не более:

при $T = 298$ К:

2T920A	1 мА
2T920Б, KT920A	2 мА
2T920B	5 мА
KT920Б	4 мА
KT920B, KT920Г	7,5 мА
при $T = 398$ К:	
2T920A	2 мА
2T920Б	4 мА
2T920B	10 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4$ В:

при $T = 298$ К:

2T920A, 2T920Б	0,25 мА
2T920B	2 мА

Индуктивность выводов* при $l = 1$ мм:

2T920A, KT920A:

эмиттерного	1,7 нГн
коллекторного	2,4 нГн
базового	2,9 нГн

2T920Б, KT920Б:

эмиттерного	1,2 нГн
коллекторного	2,4 нГн
базового	2,6 нГн

2T920B, KT920B, KT920Г:

эмиттерного	1,0 нГн
коллекторного	2,4 нГн
базового	2,4 нГн

Емкости электродов относительно корпуса*:

эмиттер-корпус	1,84 пФ
коллектор-корпус	1,53 пФ
база-корпус	0,96 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом 36 В

Постоянное напряжение эмиттер-база 4 В

Постоянный ток коллектора:

2T920A, KT920A	0,5 А
2T920Б, KT920Б	1 А
2T920B, KT920B, KT920Г	3 А

Импульсный ток коллектора при $t_i \leq 20$ мкс, $Q \geq 50$:

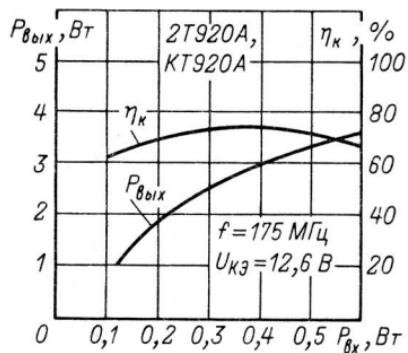
2T920A, KT920A	1 А
2T920Б, KT920Б	2 А
2T920B, KT920B, KT920Г	7 А

Постоянный ток базы:

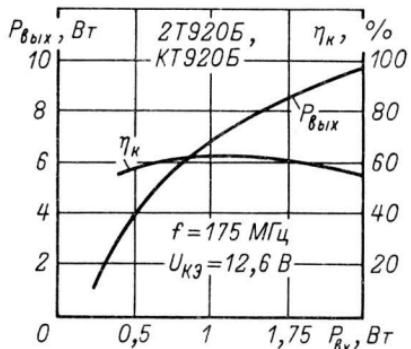
2T920A, KT920A	0,25 А
--------------------------	--------

2T920Б, KT920Б	0,5 А
2T920В, KT920В, KT920Г	1,5 А
Импульсный ток базы при $\tau_i \leq 10$ мкс, $Q \geq 100$:	
2T920А, KT920А	0,5 А
2T920Б, KT920Б	1 А
2T920В, KT920В, KT920Г	3,5 А
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме:	
при $T_k \leq 323$ К:	
2T920А, KT920А	5 Вт
2T920Б, KT920Б	10 Вт
2T920В, KT920В, KT920Г	25 Вт
при $T_k = 398$ К:	
2T920А	1,25 Вт
2T920Б	2,5 Вт
2T920В	6,2 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус:	
2T920А, KT920А	20 К/Вт
2T920Б, KT920Б	10 К/Вт
2T920В, KT920В, KT920Г	4 К/Вт
Temperatura перехода	433 К
Temperatura окружающей среды:	
2T920А, 2T920Б, 2T920В	От 213 до T_k 398 К
KT920А, KT920Б, KT920В, KT920Г	От 238 до $T_k = 258$ К

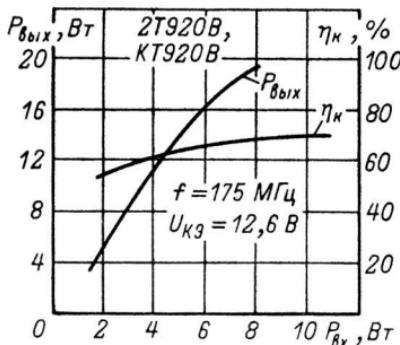
Примечание. Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 5 мм от корпуса без передачи усилия на керамическую часть корпуса, без нарушения герметичности и с сохранением обозначения коллекторного вывода.



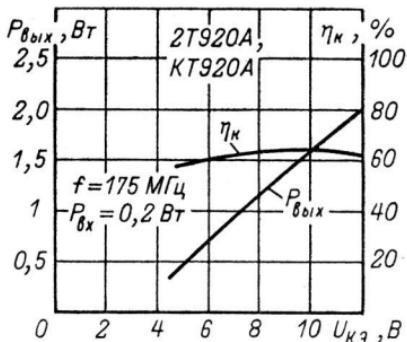
Зависимость выходной мощности и КПД от входной мощности.



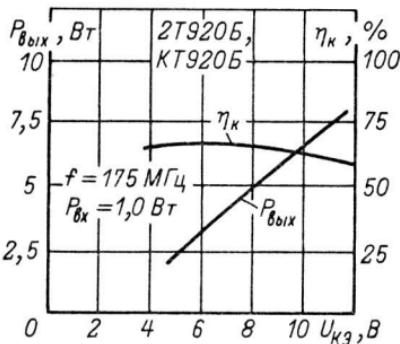
Зависимость выходной мощности и КПД от входной мощности.



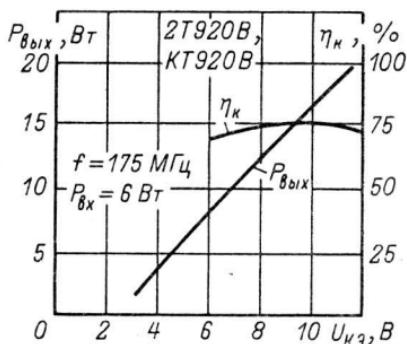
Зависимость выходной мощности и КПД от входной мощности.



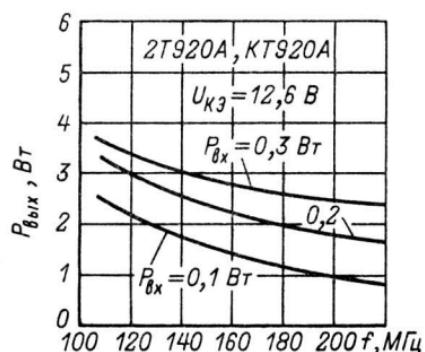
Зависимость выходной мощности и КПД от напряжения коллектор-эмиттер.



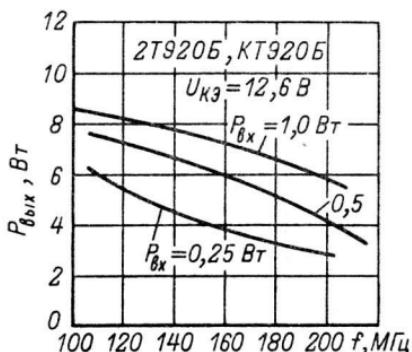
Зависимость выходной мощности и КПД от напряжения коллектор-эмиттер.



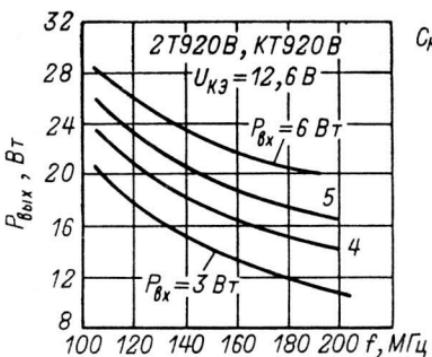
Зависимость выходной мощности и КПД от напряжения коллектор-эмиттер.



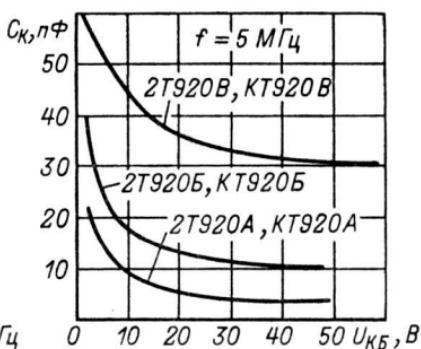
Зависимость выходной мощности от частоты.



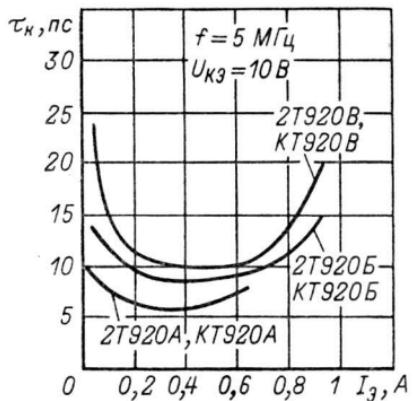
Зависимость выходной мощности от частоты.



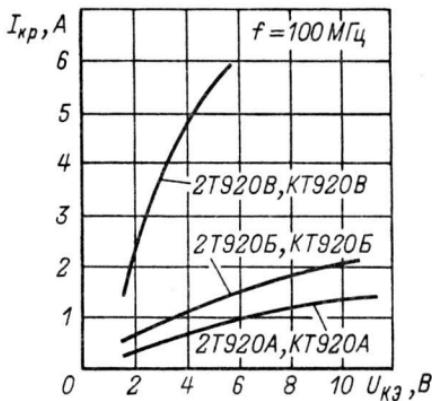
Зависимость выходной мощности от частоты.



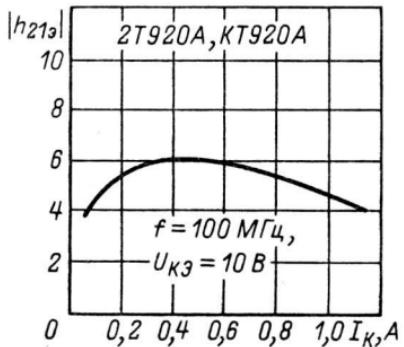
Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.



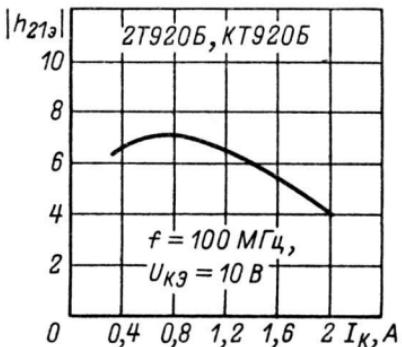
Зависимость постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера.



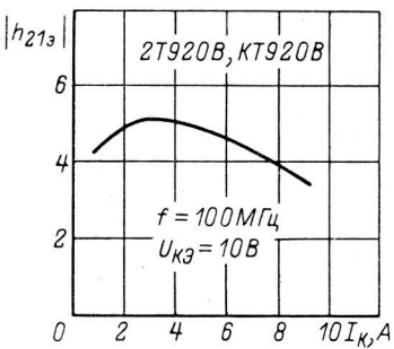
Зависимость критического тока от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора.